DIALOG(R) File 351: Derwent (c) 2002 Derwent Info Ltd. 11 rts. reserv.

011231269

WPI Acc No: 1997-209172/ 199719

XRAM Acc No: C97-067254 XRPX Acc No: N97-172793

Single crystal of barium titanate used for optical devices - contg. magnesium@, iron@ and inclusions, exerting optical reflection effect and giving high yields.

Patent Assignee: FUJIKURA LTD (FUJD); NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (NITE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 9059096 A 19970304 JP 95213315 A 19950822 199719 B

Priority Applications (No Type Date): JP 95213315 A 19950822 Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 9059096 A 6 C30B-029/32

Abstract (Basic): JP 9059096 A

A BaTiO3 crystal contains magnesium 10-500 ppm in atom, iron, 10-500 ppm in atom, and the balance, incidental inclusions, less than 50 ppm in atom.

USE - The single crystal to barium titanate is used in optical application devices, including a phase conjugate mirror, laser oscillator, or optical image analyser. The single crystal of barium titanate uses a nonlinear optical effect and enables optical signal processing.

ADVANTAGE - Adding Mg, 10-50 ppm, and Fe 10-500 ppm, to the single crystal of BaTiO3 exerts an optical reflection effect at the near IR region equiv. to that afforded by conventional Co- and Rh- doped BaTiO3, and yields the single crystal of BaTiO3 in high yield.

Dwg.0/5

Title Terms: SINGLE; CRYSTAL; BARIUM; TITANATE; OPTICAL; DEVICE; CONTAIN; MAGNESIUM; IRON; INCLUSION; EXERT; OPTICAL; REFLECT; EFFECT; HIGH; YIELD Derwent Class: L03; P81

International Patent Class (Main): C30B-029/32

International Patent Class (Additional): C30B-015/00; G02B-001/02

File Segment: CPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): L03-D01; L03-G02 Derwent Registry Numbers: 1508-U; 1510-U THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-59096

(43)公開日 平成9年(1997)3月4日

最終頁に続く

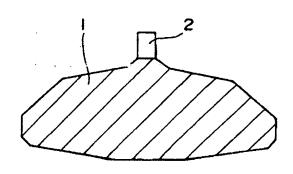
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	ΡI			ż	技術表示循所
C30B	29/32			C30B 2	9/32		С	
	15/00			I	5/00		Z	
G 0 2 B	1/02			G 0 2 B	1/02			
				審査請求	未請求	請求項の数1	OL	(全 6 頁)
(21)出願書]	特顧平7-213315	un ann an ann an ann an ann ann ann an an	(71)出顧人		86 Łフジクラ		
(22)出顧日		平成7年(1995) 8	(71) 出顧人	0000042	「東区木場 1 丁 26 1電話株式会社	∄5番1	号	
				(72)発明者	中尾 気	所宿区西新宿三门 D L東区木場1丁目		
				(72)発明者		•]5番1	号 株式会

(54) 【発明の名称】 チタン酸パリウム単結晶

(57)【要約】

【課題】 高い光屈折性効果を有すると共に、歩留りが 高く、製造コストが低いチタン酸バリウム単結晶を提供 する。

【解決手段】 BaTiO3結晶中にMg及びFeを原 子濃度で夫々10ppm乃至500ppm含有し、不可 避的不純物の原子濃度が50ppm未満である。



社フジクラ内 (74)代理人 弁理士 藤巻 正憲

7.1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 BaTiO3結晶中にマグネシウムを原 子濃度で10ppm乃至500ppm、鉄を原子濃度で 10ppm乃至500ppm含有し、残部の不可避的不 純物が原子濃度で50ppm未満であることを特徴とす るチタン酸バリウム単結晶。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高い光屈折性効果を有 し、位相共役鏡、レーザ共振器及び光学画像解析機器等 10 の光学応用機器において非線形光学効果を利用した光信 号処理等に使用可能なチタン酸バリウム単結晶に関す

[0002]

【従来の技術】従来から 光屈折性効果を示す結晶を使 用することにより、ホログラムの記憶、光の増幅又は位 相共役光の発生が可能になることが知られており、近 年、光屈折性結晶を光画像処理、光演算及び光コンピュ ーティング等に応用する研究が活発に行われるようにな った(北山、応用物理学会結晶光学分科会第95回研究 20 テキスト、第13頁、1991年)。種々の光屈折性結 晶のうち、特にチタン酸パリウム (BaTiO₂)単結 晶は比較的大きな光屈折性効果を示すことが知られてお り、最も実用化が期待されている。

【0003】近時、近赤外波長半導体レーザの広範な普 及により、従来では450nmから600nm付近の可 視光領域でのみ利用されてきたこの光屈折性効果を、長 波長の領域にまで広げることが要望されている。BaT iO2単結晶の光屈折性は、酸素欠損又は不純物元素等 生し、このフォトキャリヤが結晶中を移動し再分布し て、電場を形成することに基づくといわれている(P.Gu nter, J.P. Huignard編" Photorefractive Materials and Their Applications I, Vol.61 of Topics in Applied Physics, Springer, Berlin, 1988)。このため、結晶 中に存在する不純物元素の量及び種類が異なれば、光屈 折性効果の大きさ及び光の波長に対する感度もそれらに 依存して変化する。従って、適当な欠陥を導入すること によって、より低いエネルギー、即ち、より長波長の光 で光屈折性を誘起できる可能性がある。これまでに、近 40 赤外領域におけるBaTiO3単結晶の光屈折性効果を 高める方法として、コバルト (Со) 又はロジウム (R h)をドープする方法 (D.Rytz et al., Opt.Lett., Vo 1.15, p1279(1990), B.A. Wechsler et al., Opt.Lett., Vol. 19, p536(1994)) が提案されている。BaTiO3 にCo又はRhをドーピングすることによって、従来よ り長い波長における感度を高めることを目的としてい る。

【0004】一般に、Co又はRhがドープされたBa TiO3単結晶は、以下に示す方法により製造されてい

る。即ち、先ず、不純物元素を所定の含有量で添加した 二酸化チタン(TiO1)及び酸化バリウム(BaO) の混合原料を出発原料とし、TSSG法(種結晶溶融引 上げ法: Top-seeded Solution Growth Technique: A. Lin z et al J. Electrochem. Soc., Vol. 112, 600, (1965)) により、図1に示すよううに、この出発原料の融液から 種結晶2を核としてBaTiO3単結晶1を育成する。 次に、この単結晶を(100)面又は(001)面に沿 って6面体に切断し、この6面体の全ての面を鏡面研磨 する。次いで、単結晶中の誘電分域を一つに備えるため に、単分域化処理を行う。このようにして、図3に示す ように、光学応用機器等に使用可能なBaTiO3単結 晶4が得られる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の Co又はRh等の不純物をドープしたBaTiO₃単結 晶は、近赤外領域において高い光屈折性効果を示すもの の、実用上必要とされる特性を得るためには500pp m以上のドーパントの添加が必要であった。この多量の ドーパントの添加は、結晶育成及びポーリング処理に困 難をもたらし、結晶製造において大幅な歩留りの低下を 招いていた。従って、近赤外領域で高い光屈折性効果を 得るため、高濃度にCo又はRhを添加した結晶は極め て高価になり、その応用分野への適用が制限されてい た。

【0006】即ち、Co又はRhを添加することによ り、長波長の光(低いエネルギー)で励起されるキャリ ヤをBaTiO3結晶中に導入することができる。Co 又はRhドープのBaTiO3単結晶では、ドーパント の結晶欠陥部から、光で励起されたフォトキャリヤが発 30 の添加量に依存して、近赤外領域での光屈折性効果は上 昇するが、実用レベルの特性を得るためには、最低でも 500ppm以上、できれば1000ppm以上の添加 、が必要であった。しかしながら、融液中に添加したドー パントの濃度が500ppmを超えると、TSSG法に よる結晶育成の際、種結晶以外に結晶の核発生が起こり やすい。 即ち、 図2に示すように、 種結晶2から成長し た単結晶1の外に、個々の核から成長した単結晶3が存 在し、高品質の結晶が得られ難くなる。育成した結晶 は、空隙、気泡、クラック及び残留応力を多く含み、採 取できる製品の数量が減少するばかりでなく、5mm× 5mm×5mm以上の大型の試料を得ることも極めて難 しい。更に、図4に示すように、分域も除去されにくく なる傾向があり、残留分域5が発生してボーリング処理 にも困難が生じる。以上の理由から歩留りが著しく低下 するため、大幅なコストの上昇は避けられなかった。 【0007】本発明はかかる問題に鑑みてなされたもの であって、高い光屈折性効果を有すると共に、歩留りが 高く、製造コストが低いチタン酸バリウム単結晶を提供 することを目的とする。

50 [0008]

3

【課題を解決するための手段】本発明に係るチタン酸バリウム単結晶は、BaTiO3結晶中にマグネシウムを原子濃度で10ppm乃至500ppm、鉄を原子濃度で10ppm乃至500ppm含有し、不可避的不純物が原子濃度で50ppm未満であることを特徴とする。但し、不純物及び添加物の濃度はBaTiO3分子に対する原子濃度(ppm in atom)である。【0009】

【作用】前述のように、近赤外領域で高い光屈折性を示す結晶は、同領域において比較的大きな光吸収を示す。 10 この理由は、不純物等による欠陥部から価電子が励起されるときに、励起エネルギーに等しい波長の光を吸収するためであって、近赤外領域における光吸収係数が高いことが、近赤外領域で高い光屈折性を示す一つの指標になっている。本願発明者等は、種々のドーパントを添加したBaTi〇3を育成し、それらの吸収係数を調べたところ、Со及びRh以外に、Mgが添加濃度の割に高い光吸収係数を示すことを見出した。この結果に基づき、Mgをドープした結晶を多種類作製し、それらの近赤外における光屈折性効果を評価したところ、一部の結ねい特性を示したが、ロットごとに特性が異なっていた。

【0010】可視領域での光屈折性効果を高める代表的 なドーパントとして鉄 (Fe) があるが、Feは不可避 な不純物として最も混入しやすい元素の一つでもある (M.B.Klein et al., J.Opt.Soc.Am.B, Vol.3, p293, (1 986), P.G. Schunemann et al., J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 5, p1702.(1988))。このため、育成ロット間におけるB aTiO3単結晶の光屈折効果のばらつきは、主として Feの偶発的な汚染によると考えられている。同様に、 近赤外領域における特性にも汚染の影響が予想される。 本願発明者等は、Mgドープ時の特性の不安定性の要因 としてFeに着目し、MgとFeを同時に添加してBa TiO3を育成したところ、少ない添加量でも、従来の Co及びRhドーブBaTiOgと同等の近赤外領域に おける光屈折性効果を観測した。これまでの結果から、 MgとFeの2種類の欠陥が同時に存在するとき、それ らの光屈折性効果に対する寄与がきわめて効率的に行わ れているものと考えられる。

【0011】更に、本願発明者等は種々の濃度でMg及 40 びFeを添加したBaTiO3を育成し、有効な濃度の範囲を見い出した。即ち、Mg及びFeは低濃度ではBaTiO3中のキャリヤ増大の効果は得られないし、高濃度になると良質な結晶を育成することが困難になるため、最適なMg及びFeの濃度範囲が存在する。本願発明者等による多数の実験研究の結果、結晶中に含まれるMgの濃度を10ppm乃至500ppm、Feの濃度を10ppm乃至500ppmとする必要があることが判明した。

[0012]

【実施例】以下、本発明の実施例についてその比較例と 比較して説明する。先ず、光吸収係数及び応答速度等の 測定方法について説明する。

【0013】図5は2光波混合の測定系を示す。レーザ 一光源11から出たビームは、反射鏡によりビームスプ リッタ13に導かれ、ビームスプリッタ13により2方 向に分割される。これらのビームは反射鏡2により反射 して、所定の角度をなして被測定結晶17中で交差する ように、被測定結晶17に入射する。分割されたビーム 10 の一方を信号光15、他方を参照光16とすると、フォ トリフラクティブ効果によって、結晶中で参照光16の エネルギーの一部は信号光15へと移り、信号光15は 増幅されてディテクタ18により検出される。信号光1 5と参照光16を交差させたときの信号光の強度と、シ ャッタ14により参照光16を遮り、信号光15のみを 透過させたときの信号光の強度から、2光波の相互作用 による結合係数厂が下記数式1により求められる。但 し、信号光の強度は参照光の強度より十分に小さいもの とする。

0 [0014]

30

【数1】 F = (1/L) In (Is: (2光波混合時) / Is (信号光のみ透過) }

【0015】なお、Isは結晶中を透過、又は結晶中で 増幅された信号光の強度を表し、Lはビームが透過する 方向での結晶の長さを表わす。

【0016】本試験において、使用したレーザー光源は 半導体レーザーで波長が830nm、偏波は異常光で、 参照光の強度は40mW/cm、信号光の強度は2mW /cmである。また、ビームの偏波面は入射面内にあり (P偏光)、2本のビームの入射角は結晶の入射面の法 線に対し14°、結晶のC軸は入射面内で光伝搬方向に 垂直とした。光屈折性結晶を画像処理又は画像の記録再 生等に適用するために、目安として本条件で測定した結 合係数が1.5cm-1以上必要である。

【0017】従来例

従来の主なドーパントとしてCo又はRhをドープした BaTiO3単結晶の特性を下記表1に示す。Co又は RhドープBaTiO3は、TiO2とBaOを66:3 4のモル比で混合した融液中にCo3O4又はRh2O3を の 所定量加えた後、約1400℃の温度からTSSG法に より育成した。約150時間育成したところ、得られた 結晶の大きさは30mm×30mm×20mmであった。X線回折法によって結晶方位を調べ、主軸方位に沿って約5mm角の立方体に切り出した後、ダイヤモンドスラリーを用いて表面に光学研磨を施した。ポーリングは2段階処理とし、結晶の2方向から20MPaの圧力を加える機械的処理の後、125℃中で2kV/cmの直流電場を10時間印加する電気的処理を行った。Coを100ppmから2000ppm添加した5種類のB aTiO3結晶を上記の方法で作製したところ、表1に

示すように、Coの添加量が多くなるほど一回の育成で 採取できる試料の量は少なくなった。この傾向は、Rh についても同様であった。この理由は、前述の如く、ド ーパンド濃度の増加に従って、育成した結晶中に空隙及 びクラックが増えてくるためである。表1に示した「相 対歩留まり」は、育成した結晶から採取できる製品の重 量をドープしない結晶を100とした場合の相対値で表 した値である。結合係数は、光屈折性効果の高さを評価 する最も直接的で有効な指標であり、その値が大きいほ 示す2光波混合試験によって測定した。

【0018】そして、この5種類のCoドープBaTi O3及び5種類のRhドープBaTiO3の2光波混合に おける結合係数と相対歩留まりを表1併せてに示す。こ の表1からわかるように、BaTiO₂にCo又はRh をドープすると、その濃度に従って近赤外領域の結合係 数は上昇した。実用的な特性である1.5cm-1の結合 係数を得るためには、Co又はRhを1000ppm以 上添加すればよいことが判る。しかし、このように多量 にCo又はRhを添加すると、相対歩留まりが急激に低 20 下し、ドープしない結晶に比べ、Co1000ppm以 上では10%以下、Rh1000ppm以上では15% 以下まで相対歩留りが低下する。

【0019】実施例

本発明の実施例として、Mg及びFeをドープしたBa TiO3単結晶を作成した。即ち、MgOとFe2O3を 融液中に添加してTSSG法によりMg及びFeドープ BaTiO3単結晶を育成した。先ず、比較のためMg 又はFeを単独に2種類の濃度で添加した結果を作製 し、次にそれらを6種類の組み合わせで添加した。ドー 30 【0021】 パント以外の育成条件及び加工条件はCoドープと同様 とした。Mg及びFe単独ドープ及び6種類のMg及び*

*FeドープBaTiO3の光屈折性効果の高さを示す結 合係数とドープしない結晶に対する相対歩留まりを下記 表2に示す。Feを単独にドープした場合、ドープなし に比べて歩留りの低下は少ないが、近赤外領域における 結合係数はほとんどOであった。Mg単独ドープでは、 その添加による結合係数上昇という効果は認められるも のの、その値は結晶によって大幅に異なり、添加の効果 が安定しなかった。MgとFeを同時に添加した場合 は、Mg濃度及びFe濃度が夫々10ppmからその濃 ど光屈折性が優れているといえる。結合係数は、図5に 10 度に依存して結合係数が上昇した。Mg濃度が100p pm、Fe濃度が50ppmでは1.5cm⁻¹の結合係 数が得られ、Co又はRhに比べて低い濃度で、優れた 特性が得られることがわかった。そのときの相対歩留り は、添加濃度が低いため85%と良好であった。Mg及 びFeの添加量を増加して行くと、それに従って結合係 数も上昇するが、各ドーパントの濃度が500ppmを 超えるあたりから、相対歩留りは50%を下回り、以 後、急激に低下した。

6

【0020】以上の結果から、Mg及びFeは単独でB a TiO3に添加しても、近赤外領域における光屈折性 効果を安定して得ることはできないが、それらを同時に 添加することによってBaTiO3に高い光屈折性を誘 起できることがわかった。そのために必要な機度は、通 常約100ppmと従来のドーパントに比較してはるか に少ないため、ドーパント添加に依る結晶製造の歩留り の劣化も少なくできる。従って、MgとFeを夫々10 ppm乃至500ppmの範囲で添加することにより、 従来に比して高い歩留りで、近赤外領域において特性が 良いBaTiO3結晶を育成できる。

【表1】

ドーパント	濃度(ppm)	結合係数	相対歩留り(%)
Со	100	0. 2cm ⁻¹	. 85
Co	200	0.5cm ⁻¹	85
Co	500	1. 1cm ⁻¹	55
Co	1000	1.6cm ⁻¹	10
Со	2000	2. 0cm ⁻¹	5
Rh	200	0.1cm ⁻¹	85
Rh	500	0.8cm ⁻¹	40
Rh	1000	1.8cm ⁻¹	15 .
Rh	2000	2. 5cm ⁻¹	10
Rh	3000	3. 5cm ⁻¹	5

8

Mg濃度(ppa)	Fe濃度(ppm)	結合係数	相対歩留り(%)
0	100	0.00cm ⁻¹	95
0	500	0. 05cm ⁻¹	90
100	0	0.8cm ⁻¹	90
500	0	0.4-1.7cm ⁻¹	65
10	10	0. 41cm ⁻¹	90
100	50	1.5cm ⁻¹	85
200	150	2. 0cm ⁻¹	70
500	300	2.6cm ⁻¹	60
500	600	2.8cm ⁻¹	40
800	300	2.8cm ⁻¹	30

[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係るBaTiO3単結晶は、Mgを10ppm乃至500ppm含有すると共に、Feを10ppm乃至500ppm含有するため、近赤外領域において高い光屈折性効果を持つと共に、従来より高い歩留りで製造することができる。【図面の簡単な説明】

【図1】育成後のBaTiО₃単結晶を示す断面図である

【図2】高濃度ドーブ原料から育成したBaTiO3結晶を示す断面図である。

【図3】ボーリング後の結晶を示す模式図である。

【図4】ボーリング後の高濃度ドーブ結晶を示す模式図である。

【図5】2光被混合の実験系を示す図である。

*【符号の説明】

1;単結晶

2;種結晶

3:個々の核から成長した単結晶

4;単分域BaTiOs単結晶

20 5;残留分域。

11;レーザー光源

12; ミラー

13;ビームスプリッタ

14;シャッター

15;信号光

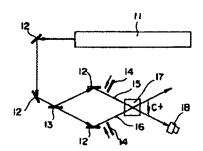
16;参照光

17;被測定結晶

18;ディテクタ

[图1] [图2] [图3] [图4]

【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 黒坂 昭人

東京都江東区木場1丁目5番1号 株式会 社フジクラ内 (72)発明者 伊藤 文彦

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 北山 研一

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内